ビーム衝突点超伝導電磁石

I はじめに

ここでは SuperKEKB に設置された衝突点超 伝導電磁石について述べる. 超伝導, 超伝導電磁 石の一般論については過去の OHO のテキスト を参照してして下さい [1-4].

SuperKEKB は7 GeV の電子と4 GeV の陽電 子を正面衝突させる周長 3 km の衝突型加速器 (コライダー)である. 衝突によって生じる素粒 子反応を Belle II と呼ばれる大型素粒子検出器 を使って調べることを目的としている. 図1に SuperKEKB の全体図を示す. Linac で加速され た電子ビーム, 陽電子ビームは各々 HER(High Energy Ring), LER(Low Energy Ring) と呼ばれる メインリングに入射されて, 周回し, ビーム衝突 点 (Interaction Point: IP) にて衝突する. 尚, 各メイ ンリングではビームエネルギーは変化しない.



図 1: SuperKEKB 衝突点 (Interaction point) の位置 (図右上)

ビーム衝突点超伝導電磁石とは, ビーム衝突 点領域 (Interaction Region:IR) に設置され, IP で のビームサイズを小さくする役割を持つ電磁石 システムである. 呼び方は他にも最終集束磁石 システム (Final Focus System), 低ベータ挿入磁石 (Low Beta Insertions) 等がある. これは通常, 4 極 電磁石をダブレットもしくはトリプレットに配 置したものとなっている.

SuperKEKBではルミノシティを高めるために ナノビームスキームと呼ばれる方法を採用して いる.ナノビームスキームでは,衝突点での交差 角を大きくすることにより,砂時計効果の制限 を受けることなくルミノシティを高めることが 出来る.衝突点でのビーム交差角を 2¢ とする とルミノシティは簡略化のため衝突点における ビーム間のクーロン力による集束効果 (ビーム ・ビーム効果)を無視すると,以下の式で表わさ れる [5, 6].

$$\mathscr{L} = \frac{N_+ N_- f}{4\pi \sigma_z \sin \phi \, \sigma_y^*} R_L \tag{1}$$

$$\sigma_y^* = \sqrt{\beta_y^* \varepsilon_y} \tag{2}$$

ここで, N_+ , N_- , f はそれぞれ 1 バンチに含まれ る陽電子, 電子数, バンチが 1 秒間に衝突する回 数である. また, ε_y , β_y^* , σ_y^* , σ_z はそれぞれ, 鉛直方 向エミッタンス, IP における鉛直方向の β 関数, ガウシアンビームを仮定した時の IP における鉛 直方向のビームサイズ, バンチ長である. ここで は電子・陽電子は同じビームサイズと仮定して いる. R_L は有限交差角による減少等を補正する 幾何学的補正係数である.

この式から β^* を小さく絞ることでルミノシ ティを高めることが出来ることがわかる.こ の役割を担うのがビーム衝突点電磁石である. SuperKEKB では低エミッタンス,低 β_y^* ラティス 設計により σ_y^* を KEKB の 1/20 とし、この部分 のルミノシティゲインを 20 倍にしている.

SuperKEKB の衝突点に関するメインパラメー ターを表 1 に示す. ここで上付きの * は IP での 値を意味している. $\epsilon_{x,y}$ は x, y 方向のビームエ ミッタンス, $\sigma_{x,y}^{*}$ は衝突点でのビームサイズ, σ_{z} はバンチ長を表わす. 衝突点でのビームサイズ は水平方向に, 10 µm, 鉛直方向に 50 nm となる.

表 1: SuperKEKB メインパラメーター [7]. * は IP での値を示す. $\varepsilon_{x,y}$ は x, y 方向のビームエミッタ ンス, σ_x^*, y は衝突点でのビームサイズ, σ_z はバン チ長を表わす.

| Parameter | LER | HER |
|-------------------------------------|------|------|
| β_x^* [mm] | 32 | 25 |
| β_y^* [mm] | 0.27 | 0.30 |
| ε_x [nm] | 3.2 | 4.6 |
| $\boldsymbol{\varepsilon}_{y}$ [pm] | 8.64 | 11.5 |
| σ_x^* [nm] | 48 | 59 |
| σ_{y}^{*} [µm] | 10 | 11 |
| σ_{z} [mm] | 6 | 5 |

2 衝突点電磁石 (QCS) 概略

2.1 QCS 全体構成

SuperKEKBの衝突点電磁石は図2に示される ように,超伝導四極電磁石,超伝導補償ソレノイ ド,超伝導補正/キャンセル電磁石から構成され る超伝導電磁石の複合体である.以下では各電 磁石の概略について述べる.

2.1.1 超伝導四極電磁石

衝突点の β を絞るには高い磁場勾配の 4 極 電磁石を IP 近傍に設置する必要がある. IP で は Belle II 検出器から空間的な制限を受ける (図 2) ので SuperKEKB では衝突点電磁石とし て超伝導電磁石が採用された. SuperKEKB では この衝突点電磁石を"QCS" と呼んでいる. これ は SuperKEKB のラティス設計において本電磁 石を識別する名称であり, 各アルファベットは Quadupole, Colliding section, Superconducting を意 味している. 以降では QCS と呼ぶ.

QCS は 2 台の 4 極電磁石を使って, IP 上で鉛 直, 水平方向にビームを集束する. このような 4 極電磁石の配置は一般的にダブレットと呼ばれ ている. また 3 台で集束する場合はトリプレッ トと呼ばれる. LHC の衝突点電磁石はトリプ レットを採用している. IP 通過後, ビームプロ ファイルを元に戻しビームを周回させるために, IP 下流側にも IP に対して対称なダブレットが 設置される.このため, HER, LER の各リングに それぞれ4台の4極電磁石が必要となる.即ち, QCS では合計8台の4極電磁石が用いられる. QCSの4極電磁石は以下のように名前が付けら れている.

■LER QC1LP, QC2LP, QC1RP, QC2RP

■HER QC1LE, QC2LE, QC1RE, QC2RE

ここで QC は QCS の QC であり,数字の1,2 は それぞれ鉛直,水平方向の集束を意味している. 数字の次の文字, L/R はリング中心から見て衝突 点の左側,右側に設置されるものをそれぞれ L, R として区別している.また最後の文字 P/E は 電磁石が設置されるリング, Positron ring (LER), Electron ring (HER) を意味している.

2.1.2 超伝導補償ソレノイド

QCS は Belle II 検出器内に設置される. Belle II 内には発生粒子の運動量を分析するため, 超伝 導ソレノイドによる 1.5 T の磁場が印加されて いる. この磁場はビームにとっては望ましくな い水平方向と鉛直方向の運動が結合する (x-y カップリング) 現象の要因となる. この磁場を打 ち消すため, Belle II ソレノイド磁場とは逆向き の磁場を発生する超伝導ソレノイド (補償ソレ ノイド) が4 台設置される. ビーム軸に沿って積 分された (Belle II ソレノイドと補償ソレノイド を合わせた) ソレノイド磁場が零になるように 補償ソレノイドは設計された.

2.1.3 超伝導補正/キャンセル電磁石

各4極電磁石には4極磁場による誤差成分を 補正するための4極電磁石1台に対し4~5台の 超伝導補正電磁石が組込まれている。

また, 衝突点に最も近い 4 極電磁石 (QC1LP, QC1RP) は陽電子リング (LER) に設置されるが, この位置は対向する電子リング (HER) に近接 しており, 4 極電磁石が発生する漏れ磁場の電 子ビームへの影響は無視出来ない. 補償ソレノ イドによる磁場が 2 Tesla を越えるため, 磁性体 による磁気シールドは使用出来ない. この漏れ



図 2: 衝突点領域 (IR). 図の左下か右上へ進む矢印が電子ビームライン (HER), 図の右下から左上に進む矢印が陽電子ビームライン (LER) を表わす.

磁場に対し, 逆方向の磁場を発生し, 打ち消すた めの超伝導キャンセル電磁石が HER に設置さ れる.

補正電磁石/キャンセル電磁石の台数は計 43 台である.

2.2 クライオスタット

QCS を構成する超伝導電磁石は IP をはさん で2台のクライオスタット内に格納される.

クライオスタットは超伝導電磁石を格納し, その超伝導状態を保持するための低温容器であ り,一番外側は真空容器となっており,その内側 にヘリウム容器が格納されている. ヘリウム容 器は冷凍機から送られてくる液体ヘリウムで超 伝導電磁石を浸漬し、超伝導状態に保つもので ある. 図 3,4 に QCS-L, QCS-R のヘリウム容器 の平面図を示す. QCS-L クライオスタット内に はヘリウム容器は2台設置されており,そのう ちの1台に QC2LE が単独でヘリウム容器に格 納されている. 他の3台の四極電磁石はもう1 台の容器に格納されている. QCS-R のヘリウム 容器も同様の構成である.

各ヘリウム容器は室温からの熱侵入を小さく するために,8本の支持ロッドで真空容器から支 えられている.また,補償ソレノイド磁場とBelle II ソレノイドとの間には 52.6 kN/35.7 kN(QCS-L/-R) の電磁力が働く.この電磁力に耐えられる ようにロッドの材料はチタン合金 (Ti-6Al-4V) と なっている.

ヘリウム容器を含む各電磁石の断面図を 図 5,6 に示す.各断面図の最外層がヘリウム 容器を表わしている.QC1E,QC2P には磁石本体 のヨーク以外にも対向ビームラインに磁気シー ルドが,QC2LP,QC2RE には鉄製支持構造 (Iron support frame) が組込まれている.また,IR では ビーム起因による不要な (測定のバックグラウ ンドとなる)放射線が発生し (Radiative BhaBha 散乱によって発生するγ線等),放射線損傷によ り Belle II 内の検出器の寿命が短くなってしま



う. この放射線から検出器を保護するため, IP 側 の四極電磁石はタングステン遮蔽ブロックで覆 われている.

2.3 KEKBと SuperKEKBのQCSの違い



図 8: SuperKEKB の衝突点電磁石システム

図7に示すように KEKB ではビームの交差 角は 22 mrad で、1 台の集束電磁石で電子、陽 電子の2つのビームを集束させていた.また水 平方向の収束には常伝導電磁石を用いていたた め、超伝導4極電磁石の台数は2台であった。 また補償ソレノイドの台数も2台であった.一 方, SuperKEKB では、ナノビームスキームを採用 したことによって衝突点の電子ビームと陽電子 ビームの交差角は 22 mrad から 83 mrad に拡大 された. このため HER と LER のビーム間距離 が大きくなったので1台の4極電磁石で2つの ビームを集束することが出来なくなった.この ため電子・陽電子ビームに対して独立の4極電 磁石が用いられることになり、4 極電磁石の台数 は KEKB の 4 倍の 8 台となった (図 8). また補償 ソレノイドの台数も KEKB の2 倍の4 台である.

2.4 章のまとめ

- SuperKEKBの衝突点電磁石は超伝導電磁石 で構成されており、QCSと呼ぶ。
- QCS の 4 極電磁石はダブレットに配置され ており, HER, LER 各々に 2 組のダブレット

が設置されている.

- 各4極電磁石には4~5台の補正電磁石が組 み込まれている。
- IP に最も近い LER の4 極電磁石の隣の HER には漏れ磁場キャンセル電磁石が設置され ている。
- Belle II ソレノイド磁場をビーム経路の積分 として打ち消するための補償ソレノイドが 4 台設置されている.
- QCS を構成する超伝導電磁石は2台のクラ イオスタットに格納されている.
- KEKBのQCSと比較すると, SuperKEKBで は四極電磁石の台数は4倍, 補償ソレノイド の台数は2倍となっている.

3 四極電磁石

加速器において用いられる四極磁石(Quadrupole magnet)は主にビーム集束・発散の 役割を持つ.四極磁石はビーム軸を基準とした x(水平)軸/y(鉛直)軸上に以下の磁場勾配を生成 する(付録 B 参照).

$$B_{\nu}(x) = Gx \tag{3}$$

$$B_x(y) = Gy \tag{4}$$

ここで Gを磁場勾配と呼ぶ.

常伝導電磁石は鉄芯形状によって磁場勾配を 形成するのに対し,超伝導電磁石はビーム軸に 対して垂直な平面で切った断面上の導体の配置 によって磁場勾配を形成する.この時の基本的 なコイルの配置は4つのコイルをビームパイプ を取り囲むように円筒形に組み合わせたものと なる(図 9).この時,四極電磁石の磁力線は断面 で見ると図 10 のようになる.

4 QCS 主四極電磁石

ここから QCS の 4 極電磁石本体の具体的な 製作工程を見ながらその構造について述べる.

補正電磁石のスキュー4極電磁石と区別する ため,集束の役割を担うものを主四極電磁石と 呼ぶ.



図 9:4 極電磁石の簡略モデル.4つの鞍型コイ ルをビーム軸に沿って組み合わせて組立られる. 上:4 コイル組立前.下:4 コイル組立後.灰色の パイプが加速器のビームが通過する真空パイプ.

QCSの主四極電磁石の基本的な構造は前節で 述べたものと同じである.

実際には必要な導体位置精度,電磁力に対す る機械的強度,超伝導状態の保持等のために工 学設計,加工方法には工夫が施されている.

我々は8台ある主四極電磁石の内、QC1Pと QC1Eについてはまず実機と同じものをプロト タイプ機としてKEKにおいて製作し,性能試験 (磁場測定)を実施した上で実機の製作に入った.

実機の製作はメーカーが行なったが,製作用 の巻線機,カラーリングプレス機等、主な巻線,



組立に必要な機器は、KEK 側が支給した. 製作 途中に必要な磁場測定は、工場にハーモニック コイル測定システムを持ち込んで実施した.

各四極電磁石が完成した後,単体での性能を 確認するため,縦型クライオスタットを用いて 液体ヘリウムに浸漬し,定格励磁試験,遮断試 験,ハーモニックコイルによる磁場測定を実施 した.

QCS の四極電磁石の定格励磁試験においては クエンチトレーニング*1 の必要はなかった.

QCS 四極電磁石の主なパラメーターを表 2 に 示す.

4.1 超伝導線材料

発生磁場が1 Tesla を越えるような加速器用超 伝導電磁石には通常 Rutherford cable と呼ばれる 超伝導ケーブルが用いられることが多い. QCS の主四極電磁石に用いられている超伝導ケーブ ルも Rutherford cable である.

これは 5~13µm の NbTi のフィラメントをを 1000~3000 本入れ複合多芯超伝導線 (ストラン ド)(外形 ~1 mm 以下) を 10~30 本撚り合わせ,

^{*1} 超伝導電磁石の完成後,最初に定格励磁する際,途中 でクエンチが発生することがある.クエンチ→励 磁→クエンチ...を繰り返すことで徐々にクエンチ 時の電流値が上昇し,定格励磁に到達する.このよう な現象をトレーニングと言う.これは励磁の際に超 伝導ケーブルが電磁力により変位することで内部で ジュール発熱が生じて,超伝導状態が破れるためで ある.

表 2: 四極電磁石のメインパラメーター [8]. I.D.(O.D.): 電磁石導体部の内(外)直径. G: 磁場勾配. GL: 磁場勾配の軸方向の線積分. I: 設 計電流. R_{ref}: 参照半径. Perm. (ヨーク材): パーメ ンジュール.

| | QC1P | QC1E | QC2P | QC2LE/RE |
|-----------------------|------|-------|-------|-----------|
| I.D. [mm] | 25.0 | 33.0 | 53.8 | 59.3 |
| O.D. [mm] | 35.5 | 70.0 | 93.0 | 115.0 |
| <i>G</i> [T/m] | 76.4 | 91.6 | 32.0 | 36.4/40.9 |
| GL[T] | 25.5 | 34.2 | 13.1 | 19.5/16.5 |
| $I_{\text{des.}}$ [A] | 1800 | 2000 | 1000 | 1250/1350 |
| $R_{\rm ref}$ [mm] | 10 | 15 | 30 | 35 |
| ヨーク材 | - | Perm. | Perm. | 鉄 |

それを成型し矩形にしたものである ([1, 3, 4]). 絶縁はポリイミドテープ等を用いてなされる.

ケーブル断面形状は主に, 長方形と楔形 (キー ストン) があるが, QCS に用いられているものは 断面が楔形のものである. パラメーターを表 3 に示す [9]. フィラメント径は 8 μ m, フィラメン ト数は 2113 本, ストランド径は 0.492 mm, スト ランド数は 10 本, QC1P, QC1E それぞれのキー ストン開き角は 2.1°, 1.7°, ケーブル幅は 2.5 mm である. QC1E 用の Rutherford cable の断面模式 図を図 11 に示す. また, QCS に用いられている Rutherford cable の模式図を図 12 に示す.

表 3: QCS に用いられた NbTi 製ラザフォード ケーブルのパラメーター [9]

| | QC1P/1E |
|---------------------------------------|---------------------------|
| フィラメント径 | 8 µm |
| フィラメント数 | 2113 |
| スランド径 | 0.498 mm |
| スランド数 | 10 |
| キーストン角 | 2.1° / 1.7° |
| ケーブル幅 | 2.5 mm |
| 臨界電流 (I _c) at 5 T, 4.22 K | 316/308 |



図 11: QC1E 用 Rutherford cable 断面模式図.



図 12: QCS4 極電磁石に用いられている Rutherford cable.

超伝導電磁石ケーブルは臨界電流,磁場,温度 を越えると超伝導状態が破れる.従って励磁電 流はケーブルが感じる最大磁場,温度において 臨界電流値以下となるように設計される.

図 13 に QC1P と QC1E コイルの負荷曲線 (ロードライン) と, これに用いられる NbTi 製 Rutherford ケーブルの臨界電流磁場曲線を示す. 横軸,縦軸はそれぞれケーブルに流れる電流,磁 場強度である.ここでロードラインはケーブル の最大経験磁場を関数として, その時の電流値 をプロットしたものである.臨界電流磁場曲線 は使用される超伝導ケーブルの臨界電流 (*I_c*)を 臨界磁場の関数としてプロットしたものである.

プロットのうち右上がりの曲線がロードラインで, 点線及び一点鎖線はそれぞれ QC1E, QC1Pの Rutherford Cable 上の最大磁場を励磁電流を 関数としてプロットしている.

グラフ中の右下がりの直線のうち、細い実線(赤),太い実線(青)はそれぞれ,温度が4.2 K, 4.7 K での QC1 に用いられている NbTi Rutherford cable の臨界電流磁場曲線である. QC1P についてはソレノイド磁場中に設置さ れているので, ソレノイド磁場と自身の発生す る磁場を重ね合わせたものである. そのため, 電 流値が零でも磁場は零になっていない.

超伝導線の電流もしくは磁場が増加し,ロー ドラインが臨界電流曲線を越えると超伝導状 態が破れる.この交差点の電流値と実際の運転 電流値との割合は超伝導状態を保持するための マージンを表わす(ロードライン比と呼ばれる).

ケーブルの経験磁場の計算誤差や多少の入熱 に対してクエンチが発生しないように,電磁石 の運転電流 *Iop* は *Ic* よりも低い値に設定される. (超伝導状態から常伝導状態に転移し常伝導領 域が拡大する現象をクエンチと言う.) QC1P 及 び QC1E のロードライン比を表4に示す. QC1E で約 20% の電流マージンがあるように設計さ れている.ここで運転電流は衝突エネルギーが 12 GeV の時を想定している*².

表 4: QCS 四極電磁石のロードライン比 (*I*_{op}/*I*_c). *I*_{op} は衝突エネルギーが 12 GeV の時の運転電 流値

| Magnet | <i>I</i> _{op} (12GeV) [A] | I_c [A] | $I_{\rm op}/I_c$ [%] |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------------|
| QC1P | 1773 | 2800 | 64 |
| QC1E | 1950 | 2500 | 78 |

4.2 導体配置

以下では加速器電磁石に特有の表現が出てくる. 初めて見る方は付録 A、付録 B を参照して 欲しい.

QCS の四極電磁石は純粋な4極磁場を発生 するため、2次元断面内で $\cos 2\theta$ の電流分布を 持つように導体が配置される. 楔形の Rutherford cable は2次元断面内で積み重ねて扇形になるよ うに巻線した. コイル層数は2層でそれぞれ3ブ ロックの領域に分割されて、4極磁石の Allowed



図 13: QC1P と QC1E のラザフォードケーブルの 臨界電流とコイル上の最大磁場, 細い実線(赤), 太い実線(青)はそれぞれ, 温度が 4.2 K, 4.7 K で の NbTi ケーブルの臨界電流磁場曲線.また実線 と一点鎖線はそれぞれ, QC1E と QC1P のコイル 上の最大磁場である.QC1E は自身が発生する磁 場によるもので, QC1P は自身の発生する磁場と QC1P が設置される位置でのソレノイド磁場を 重ね合わせた時の強度である.*I*op は衝突エネル ギー 12 GeV の時の QCS の運転電流値である.

Multipole である 12 極 (b_6) 及び 20 極 (b_{10}) 成分が 小さくなるように調整されている (図 14). QC1P と QC1E の設計上の多極成分の大きさを表 5 に 示す [9]. いずれも 1 unit (四極磁場成分に対して 1×10^{-4}) 以下と非常に小さな値となっている. コイルリード端部は 4 回対称が破れ, 3 次元計 算では 8 極成分が発生しているが, 積分磁場で 1 unit 以下になるよう設計されている.

4.3 カラー

電磁力による導体の動きを抑えるための部品 であり, コイルの外周部に組込まれる. カラー でコイルにあらかじめ圧縮応力を加えることに よって, 導体に働く電磁力により、コイルが変位 することを防ぐ.

カラー材として YUS130S(新日本製鐵社製)が 用いられている. これは低温 (4.2 K) での機械的 強度, 熱膨張率, 透磁率等の特性が加速器用超伝 導カラーに最適化されたステンレス材である.

^{*&}lt;sup>2</sup> SuperKEKB の通常運転での衝突エネルギーは 11 GeV であるが, 12 GeV での運転も考えられている. QCS では 12 GeV での運転電流値を定格電流に設定して いる.

表 5: 主四極電磁石の設計多極磁場成分

| | | QC1P | QC1E |
|--------|----------|-------|-------|
| 2 次元計算 | b_6 | 0.10 | -0.06 |
| | b_{10} | -0.21 | -0.34 |
| 3 次元計算 | b_4 | 0.24 | -0.02 |
| | b_6 | 0.54 | -0.04 |
| | b_8 | 0.01 | 0.05 |
| | b_{10} | -0.21 | -0.43 |

磁場参考半径: QC1P 10 mm, QC1E 15 mm



図 14: QC1E 導体断面. 赤色で塗りつぶされてい る部分が Rutherford cable の断面である. 台形が Rutherford cable 1 本分を表わしている. 斜線部は ウェッジであり, スペーサーの役割りを果して いる.

例えば透磁率は SUS316L が 4.2 K で 1.013 に対 し, YUS130S は 1.0021 と常温での透磁率となっ ている [10]. また, 低温収縮によりプリストレ スが減少しないように, 熱収縮は NbTi よりも大 きい.

4.4 ヨーク

主四極電磁石からの対向ビームラインへの漏 れ磁場の低減と発生磁場の増強のため、QC1P 以外の電磁石にはカラー外周部に磁性体ヨーク が組み込まれている。

QC1E, QC2P は対向ビームラインとの距離が 短く, 漏れ磁場を小さくする目的で飽和磁束密 度が鉄よりも高い (2 Tesla 以上) パーメンジュー ルが使用されている. これは鉄とコバルトを 1 対1の割合で混ぜた合金である. QC2E は Belle II 磁場が減衰している位置に設置されているため, 鉄 (S10C) が用いられている.

4.5 製作工程

先にも述べたように QCS の電磁石は導体の 配置で4極磁場を発生する.このため導体の位 置は精度良く配置される必要がある.熱収縮, ローレンツ力によりコイルが変形しないように 製作されなければならない.1 unit の精度を求 める場合,電磁石断面内でのコイルの変形量は 20~30 μm 以下である必要がある [4].

このような電磁石の製作方法は Fermilab で確 立されており, QCS の主四極電磁石もこの方法 に基づいて製作された. その工程の概略は以下 の通りである.

- 1. コイル巻線
- 2. キュアリング
- 3. カラーリング
- 4. スプライス処理
- 5. コレクターの組込み

4.5.1 巻線



図 15: 巻線風景

コイルは2層でダブルパンケーキ巻と呼ばれ る方法で巻線される.これは2層目と1層目の 層間渡り部から1層目を巻き始め,1層目が巻 終わると2層目を巻く方法である.ケーブルの リード端部が1層目と2層目の同じ位置に来 るのでリード端部による漏れ磁場の影響が小さ



図 16: QC2LP の G10 製エンドスペーサー (KEK にて製作)

く出来る. また鞍型に巻線するためコイルは鞍 型成形治具 (マンドレル)の上に載せて巻線を 行なう (図 15). 各層の巻線時のテンションは約 100 N 程度とし,巻線のターン数ごとに張力は緩 められて最終的には最初の半分程度の張力とな るようにした. 巻線時にコイルの間隔を決める ガラスエポキシ材 (G10)で作られたスペーサー (図 16)、ウェッジが設計された位置に挿入され る. スペーサー,ウェッジは 25 μm の公差で製作 された.

4.5.2 キュアリング



図 17: キュアリング

マンドレルに巻線されたコイルをコイル凸面 を下にし,成形型枠にの凹面に合うように設置 し, 上部から加圧して加温成形を行なう. 加温す ることでケーブルの絶縁テープの表面に塗布さ れたエポキシ接着材を溶かす. この時の温度は 約 130°C である. 加温中は約 20 MPa でコイル成 形型枠を加圧し, コイルを成形する (図 17). コイ ルエンド部は治具を用いてコイルの軸中心方向 に設計寸法分を押し込む.



図 18: キュアリング後のコイル寸法. 左図: コイ ル長手方向の長さの設計値からのずれ. 右図: コ イルの厚みの設計値からのずれ. エラーバーは 製作されたコイル4極分の標準偏差.

図 18 にキュアリング後のコイル寸法を示す。 左側のプロットは、各電磁石の4 極分のコイル 長 L の平均値の、設計値からのずれであり, xラーバーはコイル4 極の標準偏差である。ここ で QC1LP/RP、QC1LE/RE、QC2LP/RP、QC2LE、 QC2REの長さ Lの設計値はそれぞれ、384、430、 470、593、535 mm である。ずれはほぼ±0.1 mm 以下に抑えられている。また, 図 18 の右側の プロットはコイルの動径方向の厚み t の 設計 値 (5.425 mm) からのずれであり、許容値 (±0.025 mm) 以下であった。 $L \ge t$ の定義は図 18 の上段 の図に示す。

キュアリング後の QC1E 用コイルの写真を 図 19 に示す.

4.5.3 カラーリング

カラーリングではカラーを用いて完成した4 個のコイルを円筒状に組み立てる.図20にカ ラーリング工程を示す.



図 19: キュアーリング後の QC1E コイル, 下図は リードエンド部の拡大写真.

カラーは厚み3mmのリング上の板を半割り にしたもので,外周側にキー溝が切られている. カラーは絶縁シートを含めたコイル外周の半径 に合わせた内半径で製作されている.

最初に, 製作された 4 つのコイルを円筒形の カラーリングマンドレルの周囲に取り付けて円 筒形に組み立て, カラーを 1 段ごとに分割面の 角度を 90 度変えて積み上げていく. 始めはカ ラーは最後まではまっていないので, キー溝の 位置が段ごとにずれている (図 20-(1),-(2)). 油圧 シリンダーを使ってまずカラーを四方から加圧 しキー溝よりも 1 mm 細い仮キーを差し込む. 仮キー挿入後にカラーリングマンドレルを引き 抜く.

この状態から図 20-(3) のようにカラーに 4 方 向から油圧シリンダーを使って 60 MPa の予備 応力 (プリストレス) を加える. これにより各段 のカラーのキー溝が一致するようになるので, 本キーをカラー外周に加工されたキー溝にはめ 込む. その後, 油圧シリンダーの圧力をゆるめる. この工程で用いられたカラーリングプレスの写 真を図 21 に示す.

コイルはカラーを押し広げる向きにストレス を持っているが, カラーに嵌め込まれたキーに よってカラーは広がらない. この状態でコイル の残留予備応力が 30 MPa となるように設計さ れている. 図 22 はカラーリング後の QCS-L の 主4極電磁石である.

4.5.4 スプライス

組み合わされた4つのコイルのリードをリー ドエンド部ではんだ溶接により,直列に繋ぎ合 わせる.このときクエンチ電圧検出用のリード 線(電圧タップ)も溶接する.

4.5.5 ヨーキング

QC1P 以外のカラー外周部にヨーク (パーメン ジュールもしくは鉄) を組込む (図 20-(4)).

4.5.6 コレクターの組み込み

Brookheaven National Laboratory にて製作され たコレクター/キャンセル電磁石を主4極電磁石 の内側に挿入する. 主4極電磁石と補正/キャン セル電磁石の磁場面の位相角の関係は巻線され た補正/キャンセル電磁石のサポートボビン上の キーと主四極電磁石端板のキー溝によって精度 良く決められる [11].

図 23 に組み立てられた QCS4 極電磁石の構造 を示す.

図 24 は完成後の QC1LE の外観写真を示す. 図 24 において, 写真左側が IP 側となる. IP 側 には QC1LP からの漏れ磁場を打ち消すための キャンセル電磁石が設置されている. 反 IP 側に 見えているのは QC1LE 主 4 極電磁石のパーメ ンジュールヨークである. この内側にキャンセ ル電磁石と同じボビンに巻線された 4 台の補正 電磁石が挿入されている.

図 25 は完成後の QC1LP の外観写真である. QC1LP の内側に補正電磁石が 3 台挿入されてい



図 20: カラーの組込み方法. (1),(2) リングが 2 分割されたカラーを電磁石の外周部に組み込んでいく. 厚みは 3 mm で 1 つの電磁石あたり 128(QC1P), 143(QC1E) 段積み上げる. 一段ごとに分割部が 90 度 回転するようにする. (3) 油圧シリンダーにより 4 方向からカラーにプリストレスを与える. プリス トレスを保持するためにカラーキー溝にキーを挿入する. (4) ヨークを組み込む.



図 21: カラーリングプレス機

る. 写真に見える QC1LP 外側の円筒は 8 極補正 電磁石である.



図 22: カラーリング後の QCS-L 主四極電磁石





図 24: 完成した QC1LE. 図左側が IP 側である. IP 側にキャンセル電磁石が設置されている.

図 23: QC1LE の内部構造の模式図

4.6 章のまとめ

- QCS 主四極電磁石は NbTi 製 Rutherford cable が cos2θ 巻きされた構造によって四極磁場 を生成する.
- ・各主四極電磁石の運転電流に対する電流 マージンは 20% 以上である.
- ・ 主四極電磁石の多極磁場成分は 3 次元モデ ルにおいて 1 units 以下で設計されている.
- 電磁力によるケーブルの変位を抑えるためカラーによって予備応力を与えた構造となっている。
- 対向ビームラインへの漏れ磁場を小さくするためQC1P以外の電磁石には磁性体ヨークが設置されている。

5 補償ソレノイド

Belle II 検出器内には粒子の運動量分析のため に,1.5Tのソレノイド磁場が生成されている. そ こで, 衝突点から ±4 m の距離で積分したソレノ イド磁場成分が零となるような補償ソレノイド が QCS に設置される.

補償ソレノイドは ESL, ESR1, ESR2, ESR3 の 4 台から構成されている. ESL は QCS-L 側に 設置される. また ESR1 は QCS-R に設置され,



図 25: 完成した QC1LP. 右上が IP 側, 左下が反 IP 側である. 反 IP 側に QC1LP の外側取り付け られているのは補正 8 極電磁石である.

QC1RP, QC1RE, QC2RP を覆う位置に設置され る. ESR2 と, ESR3 はそれぞれ QC2RE とその対 向ビームラインに設置される. ESL と ESR1 の ソレノイド軸は Belle II ソレノイド軸と同じ軸 上に設置される. 一方, ESR2, ESR3 はそれぞれ HER, LER の軸に合うように設置される.

既に述べたように, HER-LER ビームラインは IP において 83 mrad の交差角を持ち, IP から離れ るとビームライン間の距離が大きくなる. 従っ て両ビームラインが通過する ESL, ESR1 の内径 は IP からの距離によって拡大させる必要があ る. また, 軸方向の位置によって磁場強度を変 化させなければならない. このためソレノイド は軸方向に分割された構造となっている. また ソレノイドは自身のローレンツ力によりフープ 力以外に軸方向の圧縮応力が発生するが、分割 によってこの応力を分散させることが出来る. ESL, ESR1 のソレノイドの分割数はそれぞれ 12, 15 である. 図 26 に IR 上での補償ソレノイドと QCS のヨークを表示する.

HER 軸に沿って IP からの距離を関数とした ソレノイド磁場分布の計算値を図 27 に示す. 実 線が QCS ヨーク, 補償ソレノイド, Belle II ソレ ノイドが有る場合の磁場分布, 点線は QCS ヨー ク, 補償ソレノイドが無い場合 (Belle II ソレノ イドのみ)の磁場分布を表わしている. 横軸の原 点は IP である. IP では 1.5 T の磁場が発生して いるが, QC1LP 及び RP の位置でそれぞれ ESL, ESR1 によって, 磁場を反転させている. QC1LE, QC1RE, QC2RP の位置では補償ソレノイドによ り Belle II ソレノイドの磁場は打ち消されてほ ぼ零になっている. これらの位置での補償ソレ ノイドは主四極電磁石のヨークが飽和しないよ うに Belle II ソレノイド磁場をアクティブにシー ルドする役割を持っている.

ソレノイドコイルの超伝導線材は,断面サイズ 0.932 mm×1.384 mm の NbTi モノリスケーブルである.補償ソレノイドのパラメーターを表6に示す.

表 6: 補償ソレノイドパラメーター

| | ESL | ESR1 | ESR2, 3 |
|--------------|------|------|---------|
| コイルブロック数 | 12 | 15 | 1 |
| 運転電流 [A] | 390 | 450 | 151 |
| 蓄積エネルギー [kJ] | 106 | 244 | 1.6 |
| インダクタンス [H] | 2.5 | 8.8 | 0.14 |
| コイル内最大磁場 [T] | 3.5 | 3.2 | 0.48 |
| ロードライン比 | 0.53 | 0.51 | 0.11 |
| コイル総ターン数 | 4610 | 6237 | 1356 |

6 超伝導補正電磁石 (コレクター), 超 伝導漏れ磁場キャンセル電磁石

ここでは補正電磁石と漏れ磁場キャンセル電 磁石について述べる.補正電磁石は主4極電磁 石もしくは QC1RE/1RP と QC2RE/QC2RP の間 に設置される.主4極電磁石で発生した高次の 多極成分と4極磁場の位置ずれ等を補正し,ビー ム運転の微調整に用いられる.

これらの電磁石は米国の Brookhaven 国立研 究所 (BNL) との共同研究によって開発された. BNL が持つ特殊技術である Direct Winding 法に よって製作された.これは接着材を表面に塗 布した超伝導線を超音波で加熱し, ボビン表面 に巻かれた絶縁シートに接着するものであり, CAD 上のデータに基づいて導体を様々な形状に 設置することが出来る (図 28).

補正電磁石, キャンセル電磁石に使用されて いる超伝導線の線径は 0.351 mm, Cu/NbTi 比は 1.0, NbTi フィラメント径は 5.5 μm, NbTi フィラ メント数は 2113, 温度 4.2 K, 磁場強度 4 T にお ける臨界電流値は 156 A である.

漏れ磁場キャンセル電磁石は LER に設置され る QC1LP と QC1RP が発生する HER への漏れ 磁場を打ち消すための電磁石で, HER に設置さ れる (図 29). キャンセル電磁石は B_3, B_4, B_5, B_6 成 分を発生する電磁石 4 台から構成される. HER 軸への漏れ磁場の 6 極成分のプロファイルと キャンセル電磁石を励磁した時のプロファイル を図 30 に示す.

キャンセル電磁石は QC1E の IP 側に設置さ れる. このため, QC1E とキャンセル電磁石は同 じボビンに巻線される. このように製作された キャンセル電磁石と QC1LE 補正電磁石を図 31 に示す.

7 主4極電磁石の磁場性能

製作された4極電磁石の磁場性能評価はハー モニックコイルを用いて行なった [12, 13]. 磁場 性能評価は縦型クライオスタットを使った4極



図 26: 補償ソレノイド (赤色) と QCS ヨーク (青色) の IR での位置. 四極電磁石は表示されていない. 軸の単位は cm.



図 27: IR のソレノイド磁場分布 (HER 軸上). 実 線: QCS 補償ソレノイド有り, 点線: QCS ヨーク および QCS 補償ソレノイド無し. ソレノイド磁 場のビーム軸方向成分. 磁場プロファイルの下 に書かれている水平線は補償ソレノイドの z 方 向の位置, 4 極電磁石の z 方向の位置を示してい る. (QC1P, QC2P は LER 軸上)

電磁石単体での評価 [14] と, IR にインストール された状態で評価を行なった. ここでは IR での 磁場測定結果について述べる.

表 7: 磁場測定時のソレノイド励磁電流

| Solenoid | Belle II | ESL | ESR1 | ESR2,3 |
|-------------|----------|-----|------|--------|
| Current [A] | 4096 | 404 | 450 | 151 |

7.1 磁場の電流依存性

四極電磁石のヒステリシス, ヨークの磁気的 飽和の4極及び多極磁場に対する影響を見るた めに磁場の電流依存性の測定を行った. 使用す る電源はユニポーラ電源 [15] であるため0A→ 定格電流→0A というサイクル (2 サイクル) で



図 28: Direct winding 法によるコレクター電磁 石の巻線の様子 (於 Brookhaven National Laboratory).

測定した. 測定点ごとに電流値を固定してハー モニックコイル (ロングコイル)の波形を測定し た. Belle II ソレノイド及び QCS の補償ソレノイ ドは表 7 の電流値に設定した. 図 32 に 2 サイク ル分の Transfer function の測定値を励磁電流の関 数としてプロットした. 上段、下段のプロット はそれぞれ QC1P, QC1E の測定結果である. プ ロット内の矢印は電流変化の方向である. ここ で Transfer function は以下の式で定義される.

$$T = \int_{z_1}^{z_2} G(z) dz / I$$
 (5)

*z*₁, *z*₂ はハーモニックコイルのビーム軸方向の IP 側と反 IP 側端部の位置である. *G*, *I* はそれぞ れ 4 極磁場勾配, 励磁電流である.

QC1P は運転電流 (1625 A) 付近において 0.2%, QC1E は (運転電流: 1577 A)0.04% 程度の up ramp



図 29: 漏れ磁場キャンセル電磁石と QC1LP

(電流を変化させる時に低い電流値から高い電 流値に設置) と down ramp (高い電流値から低い 電流値に設定) に違いが見られた. QC1E は外側 にヨークが取り付けられているので電流値が 1600 A を越えるとヨークの磁気飽和の影響が見 られるが, 問題のない大きさである. ヒステリシ スの原因は超伝導電磁石特有の Persistent Eddy Current によるものである.

実際の運転ではヒステリシスの影響を考慮して, up rampの電流で磁場設定を行なっている.

7.2 誤差多極磁場成分

測定された各電磁石の多極磁場成分を図 33 に示す.各プロットの横軸は多極磁場成分の次 数,縦軸は多極磁場の大きさである.対応する電 磁石,測定電流値,参照半径は各プロット内に表 示されている.上段のプロットが QCS-L,下段が QCS-R クライオスタットに格納されている四極 電磁石である.

QC1 電磁石について $n \le 10$ の多極磁場成分は (QC1LP を除き) 1 unit 以下となっている. QC1LP についてはn = 3のみが 1 unit を少し越える程度 でその他の成分は 1 unit 以下となっている. この n = 3の誤差磁場は補正電磁石によって十分補 正可能な大きさである. ビーム光学から要請さ れる誤差磁場の大きさは QC1 については 1 unit 以下であり, この要請は満たされている. QC2 については QC2RE を除いて多極磁場成 分は 5 units 以下となっている. QC2RE につい ては n = 3,4 において大きな誤差磁場が発生し ている. ソレノイド電流をすべて切った時の QC2RE の多極磁場成分を下段右端に示した. ソ レノイドを切るとこの誤差磁場が 2 units のレベ ルまで減少していることがわかる.

7.3 軸方向プロファイル

ビーム軸方向に沿って測定した磁場プロファ イルを図 34 に示す. 図 34-a),b),c),d) はそれぞれ, 次数 n=2,3,4,6 各成分のビーム軸 (HER) に沿っ たプロファイルである. 十字, 丸及び一点鎖線は それぞれ, 測定値のスキュー成分, ノーマル成分, そして計算値のノーマル成分である. 計算はソ レノイド磁場なし, QC1LE ヨーク有りの 3D モ デルの計算値 (OPERA3D/TOSCA) である.

4 極成分のプロファイルは測定値と計算値は 良く合っている. 磁石端部において 6 極, 8 極, 12 極成分の誤差磁場 (いずれも 10 units 程度) が 発生している. ビームへの影響はビーム光学シ ミュレーションによって調べる必要がある.

7.4 磁場性能評価のまとめ

多極磁場成分は QC2RE を除き数ユニット以 下であり, 良好な結果が得られた. QC2RE に発 生した大きな誤差磁場は軸方向のスキャンの結 果から鉄ヨークの入口出口の形状に起因するも のと考えられる [13]. ここで発生しているノー マルの6極成分は補正電磁石で対応可能である. QC1LE の軸方向プロファイルはエンド部で6極 成分が発生していたが, 全体として設計値から の大きなずれは見られなかった.

8 おわりに

SuperKEKB の QCS の超伝導電磁石について 紹介した.時間の都合により,クライオスタット の設計,室温側から低温側へ電磁石に電流を供給 するための電流リード,クエンチ検出器, Single Stretched Wire 法による QCS4 極電磁石の位置測 定,ソレノイド磁場の測定等については割愛し た.また,励磁用電源については本セミナーの大



図 30: B_3 キャンセル電磁石による漏れ磁場のキャンセル (計算値). 横軸は IP からの距離. 左図: HER 軸上の QC1P による漏れ磁場の 6 極成分のプロファイル. 右図: B_3 キャンセルコイルを励磁した時の プロファイル.



図 31: キャンセル電磁石と QC1LE 補正電磁石



図 32: 測定された 4 極磁場成分の Transfer function. 上図: QC1LP (実線) and QC1RP (破線). 下 図: QC1LE (実線) and QC1RE (破線).

木氏によるテキストが参考になると思う.

QCS の実機の製作は 2013 年 6 月に開始され, 2016 年の 2 月に QCS が完成し, IR に設置された (図 35). IR での磁場測定を経て, 2017 年 5 月に Belle II が衝突点にインストールされて, QCS が Belle II にインストールされた (図 36).

製作時に発生したトラブルとしてにクライ オスタット内の放電がある. これはクライオス タットを組立後の耐電圧試験時に発生したもの である. 放電が発生した場所はクライオスタッ ト内であったので、クライオスタットを分解し て修理を行なった.この作業に2ヶ月を要した. 原因は組立時に補償ソレノイドの絶縁が破れた ことによるものであった. また、IR インストー ル後の耐電圧試験でも電流リード部で絶縁不良 が発生した.1週間程の遅れとなった.放電トラ ブルは放電箇所によっては時間のロスとなるの で、絶縁処理は注意深くなされなければならな い. また, QCS の建設では大事な工程の区切りで は絶縁・耐電圧試験を実施しており、その過程で 今回発見されたもので、実際の運転で問題が発 生するのを防ぐためにはこのようなチェックは 重要である.

本テキスト作成時点 (2019 年 7 月) で QCS は Phase-2(2018/3~7) と Phase-3(2019/3~7) の運 転期間を経験した. QCS 電磁石システムとして



図 33: 測定された主四極電磁石の高次磁場成分. 一番右下のプロットを除き, Belle II と補償ソレノイ ドは励磁されている. 塗りつぶしは skew 成分, 白抜きは normal 成分である.



図 34: ビーム軸に沿った QC1LE 主四極電磁石 のプロファイル. 十字と丸印はそれぞれ測定さ れたスキューとノーマル成分である. 一点鎖線 は計算で得られたノーマル成分である. a) 4 極成 分, b) 6 極成分, c) 8 極成分, d) 12 極成分

は大きな問題はなく順調に運転された. QCS の 役割は β_y^* を小さくすることであるが, Phase-3 までに 2 mm まで順調に絞ることが出来た.

そのような状況で,ビームによるクエンチが 予想以上に多発した. クエンチ事象の回数は



図 35: Belle II (写真右上) のインストール前に IR に設置された QCS-L(写真右) と QCS-R(写真左).



図 36: Belle II のインストール後に IR に設置さ れた QCS-L と QCS-R.

Phase-2, Phase-3 の各々の期間に 27 回, 6 回で あった. これに伴い、Belle II による Fast abort の 導入、リング内に設置されているコリメーター の調整を実施することにより, 頻度は初期に比 べて半分以下に減らすことが出来たが, 完全に 防ぐことは出来ていない. ビームが QCS 電磁石 付近でロスし, そこで発生した粒子が超伝導電 磁石の導体にエネルギーを落とすことによって, クエンチすると考えられているが, 詳細な原因 については不明である. 今後はこのクエンチの 原因を突き止めて改良していく必要がある.

付録A 磁場の表現方法

ここでは磁場がどのように表現されているの かを示す.加速器に用いられる磁石はビーム軸 垂直な平面上の2次元磁場分布が与えられ,そ れを満たすように2次元で設計される.実際は 必ずしもビーム軸と電磁石の中心軸は一致して いない(設計上のビーム軸にオフセットがあっ たり斜めに通過したりする)が,ここではビーム 軸と電磁石の軸は一致すると考える.ここで座 標系を図のように原点を通過してビーム軸に水 平面内で垂直に交わる直線として x 軸を定義す る.また y 軸は原点を通る鉛直方向の直線とし て定義する.

x,y平面に平行な磁場をH(x,y)と定義する.ス カラーポテンシャルを $\phi(x,y)$ と置くと

$$H_x(x,y) = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \tag{6}$$

$$H_{y}(x,y) = -\frac{\partial \phi}{\partial y}.$$
 (7)

またベクトルポテンシャルをA(x,y)とすると (2 次元の場合ベクトルポテンシャルはx-y平面 に垂直な成分のみとなる),

$$B_x = \mu H_x = \frac{\partial A}{\partial y} \tag{8}$$

$$B_y = \mu H_y = -\frac{\partial A}{\partial x}.$$
 (9)

ここでμ=1とすると,

$$\frac{\partial A}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$
 (10)

$$\frac{\partial A}{\partial y} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \tag{11}$$

と書ける. 複素座標系での位置座標を

$$\vec{z} = x + iy \tag{12}$$

とすると式 (10), (11) はコーシー・リーマンの方 程式となり, また,

$$W(\vec{z}) = -(A + i\phi) + \text{const}$$
(13)

とすると $W(\vec{z})$ はzの解析関数となる. この量は 加速器では使いにくいので,磁束密度で表わす.

$$dW(\vec{z}) = -\left(\frac{\partial A}{\partial x} + i\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)dx - \left(\frac{\partial A}{\partial y} + i\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)dy$$
(14)
$$= -\left(\frac{\partial A}{\partial x} + i\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)dx + -\left(-\frac{\partial \phi}{\partial x} + i\frac{\partial A}{\partial x}\right)dy$$
(15)

$$= \left(-\frac{\partial A}{\partial x} - i\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)d\vec{z} \tag{16}$$

$$= (B_y(x,y) + iB_x(x,y))d\vec{z}$$
(17)

即ち

$$\frac{dW(\vec{z})}{d\vec{z}} = B_y(x,y) + iB_x(x,y)$$
(18)

であり,

$$\vec{B}(\vec{z}) \equiv B_y(x, y) + iB_x(x, y).$$
(19)

とすると, $\vec{B}(x,y)$ は W の z に対する導関数であ るから, これも z の解析関数となる. ちなみに, z = x + iy の類推から $B_x + iB_y$ としたいかもしれ ないが, これは解析関数にはならない.

ここで, $\vec{B}(\vec{z})$ が解析関数であることが示されたので, これを以下のように展開することが出来る.

$$B(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[C(n) \exp(-in\alpha_n) \right] \left(\frac{\vec{z}}{R_{\text{ref}}} \right)^{n-1} \quad (20)$$

ここで 2n は磁極の数となる. 例えば n = 1の 場合は 2 極磁場, 例えば n = 2の場合は 4 極磁場 を表わしている. また R_{ref} は定数であり, 参照半 径と呼ばれている. $r = R_{ref}$ $z = rexp(i\theta)$ とすると,

$$B_x(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C(n) \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} \sin\left[(n-1)\theta - n\alpha_n\right]$$
(21)

$$B_{y}(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C(n) \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} \cos\left[(n-1)\theta - n\alpha_{n}\right]$$
(22)

と書ける. 上式の展開係数を実数と虚数の項に分ける.

$$C(n)\exp(-in\alpha_n) = B_n + iA_n$$
(23)

 $B_n を / - マル項, A_n を スキュー項と呼ぶ. <math>B_n$ は y = 0 で鉛直成分のみとなる. A_n は水平成分 のみとなる. スキュー項があると, x 方向と y 方 向の運動の結合が発生するので, 通常ゼロとな るように設計される. この式を式 (21), (22) に代 入すると以下の式が得られる.

$$B_x(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} [B_n \sin(n-1)\theta + A_n \cos(n+1)\theta] \quad (24)$$
$$B_y(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} [B_n \cos(n+1)\theta - A_n \sin(n-1)\theta] \quad (25)$$

 B_r, B_θ で表わすと,

$$B_r(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} \left[B_n \sin(n\theta) + A_n \cos(n\theta)\right]$$
(26)

$$B_{\theta}(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1} \left[B_n \cos(n\theta) - A_n \sin(n\theta)\right]$$
(27)

となる. ここでピュアな 4 極磁石 $(B_n = A_n = 0, n \neq 2)$ の発生する磁場は以下となる.

$$B_r(r,\theta) = \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right) \left[B_2 \sin(2\theta) + A_2 \cos(2\theta)\right] \quad (28)$$

$$B_{\theta}(r,\theta) = \left(\frac{r}{R_{\text{ref}}}\right) \left[B_2 \cos(2\theta) - A_2 \sin(2\theta)\right] \quad (29)$$

 $x 軸 (メディアンプレーン) 上 (\theta = 0, r = x)$ では、

$$B_x(x) = \frac{x}{R_{\rm ref}} A_2 \tag{30}$$

$$B_{\rm y}(x) = \frac{x}{R_{\rm ref}} B_2 \tag{31}$$

 $A_2 = 0, G = B_2/R_{\text{ref}}$ とすると、

$$B_x(x) = 0 \tag{32}$$

$$B_{y}(x) = Gx \tag{33}$$

となる. 従って 4 極磁場というのはメディアン プレーン上では, 電磁石中心からの距離に比例 して強くなる磁場である.*G* のことを磁場勾配と 呼ぶ. また, y 軸上 ($\theta = \pi/2$ rad, r = y) では

$$B_x(y) = Gy \tag{34}$$

$$B_{y}(y) = 0 \tag{35}$$

となる. B_n , A_n は式を見るとわかるように, $r = R_{ref}$ における磁束密度の大きさであるので, 単位は SI 単位系では T(テスラ), cgs 単位系では Gauss となる.

実際の電磁石では工作誤差や,コイル端部の 巻線非対称性等から,メインの磁場成分以外の 成分が発生する.2n極の誤差磁場成分にはメイ ンの磁場成分で規格化した以下のような量が用 いられる.

$$a_n = \frac{A_n}{C(m)} \times 10^4 \tag{36}$$

$$b_n = \frac{B_n}{C(m)} \times 10^4 \tag{37}$$

$$C(m) = \sqrt{A_m^2 + B_m^2} \tag{38}$$

 a_n, b_n の単位は"units" と呼ばれる無次元量である. 10^4 のファクターがかかっているのは, 通常, 加速器用の超伝導電磁石では誤差多極磁場成分の許容範囲はメイン磁極成分に対し 10^{-4} のオーダーであるからである. また大文字と小文字は使い分けられていることに注意が必要である.

A.I 章のまとめ

- 2次元近似では z = x + iy の解析関数が B_y + iB_z であり, z で級数展開することが出来る.
- 級数展開の係数の実数部をノーマル, 虚数部 をスキューと呼ぶ.
- 4極磁場は電磁石中心からの距離に比例して強くなる磁場である。
- ・ 誤差磁場を表わすのに"units" というメイン 磁場強度で規格化された値が用いられる。

付録 B 4 極磁場の発生

先にも述べた様に加速器用の4極電磁石は純粋な4極成分のみの磁場を発生することが求められる. その他の多極磁場成分は誤差磁場となり,加速器の性能を悪化させる.

超伝導電磁石では基本的にはコイル形状のみで磁場を発生するので,最適なコイル形状がどのよう なものかここで紹介する.

B.I 楕円導体による4極磁場の発生

ここで,理想的な4極電磁石の電流分布を求めてみる[16].



図 37: 純粋なノーマル4 極磁場の発生

電流密度がJで断面が楕円の導体を流れる電流による磁場は[17]によると、

$$B_{\rm in}(\vec{z}) = \frac{\mu_0 J}{a+b} [bx - iay]$$
⁽³⁹⁾

$$B_{\text{out}}(\vec{z}) = \frac{\mu_0 J}{2} \left[\frac{2ab}{\vec{z} + \sqrt{\vec{z}^2 - (a^2 - b^2))}} \right].$$
 (40)

ここで*a*, *b* はそれぞれ *x*, *y* 軸に沿った楕円半径である (図 37). この楕円を軸回りに 90 度回転し, 電流の向きを反転させたものを重ね合わせると,

$$B_{\rm in}(\vec{z}_{\rm in}) = \frac{\mu_0 J}{a+b} \left[bx - iay \right] - \frac{\mu_0 J}{a+b} \left[ax - iby \right]$$
(41)

$$= \frac{\mu_0 J}{a+b} \left[-(a-b)x - i(a-b)y \right]$$
(42)

$$=\frac{\mu_0 J(a-b)}{a+b} \left(x+iy\right) \tag{43}$$

$$=\frac{\mu_0 J(a-b)}{a+b}\vec{z}_{\rm in} \tag{44}$$

となり、1次のみの関数で表わされるので、純粋な4極磁場である.ここで磁場勾配は

$$G = \left(\frac{\partial B_y}{\partial x}\right) = \left(\frac{\partial B_y}{\partial x}\right) = \frac{\mu_0 J(a-b)}{a+b}$$
(45)

となる. これを見ると電流密度 Jを一定にして, アパーチャー (b = const)を確保しつつ磁場勾配を上 げるためには a を大きくすれば良い. ただし, これにより総電流量は増える.

B.2 フィラメント電流による磁場

次にフィラメント電流 (断面が十分細い導体を流れる電流) を考えてみる. フィラメント電流が円 柱座標系で半径 *a* の位置にあるとすると, *r* < *a* での磁場について考える. 複素磁場は以下のように なる.

$$\vec{B}_{in}(\vec{z}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{\vec{z} - \vec{a}}$$
(46)

$$= -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a \exp(i\phi)}\right) \left[1 - \left(\frac{r}{a} \exp(i(\theta - \phi))\right)\right]^{-1}$$
(47)

ここで,

$$\vec{z} = r \exp(i\theta) \tag{48}$$

$$\vec{a} = a \exp(i\phi). \tag{49}$$

である. 数学公式

$$(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$
(50)

を用いて,

$$\vec{B}(\vec{z}) = -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a \exp(i\phi)}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^{n-1} \exp(i(n-1)(\theta-\phi))$$
(51)

$$= -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \exp(-in\phi) \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} \left(\frac{\vec{z}}{R_{\text{ref}}}\right)^{n-1}$$
(52)

ここで、参照半径 (R_{ref})を導入した.式 (20)より、

$$C(n) = \left|\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right| \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1}$$
(53)

$$\alpha_n = \phi + \frac{\pi}{n}$$
(I>0の場合) (54)

$$\alpha_n = \phi$$
 (I > 0の場合) (55)

となる. 式(23)より, ノーマルとスキュー成分は以下のように書ける.

$$B_n = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} \cos(n\phi)$$
(56)

$$A_n = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} \sin(n\phi).$$
(57)

これが複素平面上の点 aexp(i)にある線電流 I が参照半径上に生成する多極磁場成分である.

B.3 磁性体の影響

ここでは内部が空芯となっている円筒状の強磁性体の内部に線電流がある場合について考える. 鏡像法を用いると鏡像電流は

$$a' = R_{\rm yoke}^2 / a \tag{58}$$

$$I' = \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right)I\tag{59}$$

$$\phi' = \phi \tag{60}$$

と表わせる.フィラメント実電流と鏡像電流を合わせた磁場の振幅と位相は式(23)より

$$C(n)\exp(-in\alpha_n) = -\left(\frac{\mu_0}{2\pi}\right) \left[\frac{I}{a} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} + \frac{I'}{a'} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a'}\right)^{n-1}\right] \exp(-in\phi)$$
(61)

$$= -\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right) \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} \left[1 + \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \left(\frac{a}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n}\right] \exp(-in\phi)$$
(62)

となる. $\mu_r \gg 1$ と考えると, $(a/R_{\text{voke}})^{2n}$ の割合で磁場は強くなる.

QCS の QC1E と呼ばれる 4 極電磁石はパーメンジュールと呼ばれる磁性体がヨークとして外周部 に組み込まれている. ここで a = 36 mm, $R_{yoke} = 47$ mm であるので, 磁性体による 4 極成分 (n = 2) 磁 場の振幅の増加分はヨークなしの場合を 1 とすると $(a/R_{yoke})^4 = 0.35$ となる.

B.4 純粋な 2m 極磁場の発生

2m 極の磁場を発生するにはどのような電流分布が必要なのかここで見てみる. 前節で考えたフィ ラメント電流が方位角方向 (r = a の円周上) に分布しているとする. ここでは電流が方位角方向に分 布を持っていると考える. この時の生成される多極磁場成分は式 (62) より,

$$\int_{0}^{2\pi} C(n) \exp(-in\alpha_n) d\phi = -\left(\frac{\mu_0}{2\pi a}\right) \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{n-1} \left[1 + \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \left(\frac{a}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n}\right] \int_{0}^{2\pi} I(\phi) \exp(-in\phi) d\phi \quad (63)$$

となる. 上式右辺の積分は

$$I(\phi) = I_0 \cos(m\phi) \tag{64}$$

とすると,三角関数の直交性より cos(mø) の項のみがゼロではない. この場合,

$$C(m)\exp(-im\alpha_m) = -\left(\frac{\mu_0 I_0}{2a}\right) \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{m-1} \left[1 + \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \left(\frac{a}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2m}\right]$$
(65)

$$C(n) = 0 \quad (n \neq m) \tag{66}$$

となる.

即ち式 (23) より

$$B_m = -\left(\frac{\mu_0 I_0}{2a}\right) \left(\frac{R_{\text{ref}}}{a}\right)^{m-1} \left[1 + \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \left(\frac{a}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2m}\right]$$
(67)

$$B_n = 0 \quad (n \neq m) \tag{68}$$

$$A_n = 0 \tag{69}$$

となる. n = mのスキュー成分のみ発生させたい場合は $I(\phi) = I_0 \sin(m\phi)$ とすれば良い. 理想的な4極 磁場を得るための, 電流分布は $I(\phi) = I_0 \cos(2\phi)$ となるので,

$$B_2 = -\left(\frac{\mu_0 I_0}{2a}\right) \left(\frac{R_{\rm ref}}{a}\right) U_2 \tag{70}$$

が得られる. このような電流分布を cos 20(コサイン 2 シータ) 分布と呼んでいる.



図 38: 扇形導体断面図

B.5 導体断面が扇形の場合

超伝導線は臨界電流密度, 機械的性質等から加速器電磁石に用いられる断面形状にはそれ程自由度 はない. QCS の4極電磁石に用いられている導体の断面は台形であり, 断面が近似的に扇形になるよ うに巻線されている. ここでは断面形状が扇形の場合について調べる. 図 38 に断面図を示す. 式 (62) において $a = r, I = Jrdrd\phi$ とすると,

$$C(n)\exp(-in\alpha_{n}) = -\int_{\theta_{1}}^{\theta_{2}}\int_{r_{1}}^{r_{2}}\left(\frac{\mu_{0}J}{2\pi r}\right)\left(\frac{R_{\text{ref}}}{r}\right)^{n-1}\left[1+\left(\frac{\mu_{r}-1}{\mu_{r}+1}\right)\left(\frac{r}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n}\right]\exp(-in\phi)rdrd\phi$$
(71)
$$= -\left(\frac{\mu_{0}J}{2\pi}\right)\left\{\int_{\theta_{1}}^{\theta_{2}}\int_{r_{1}}^{r_{2}}\left(\frac{R_{\text{ref}}}{r}\right)^{n-1}\exp(-in\phi)drd\phi + \left(\frac{\mu_{r}-1}{\mu_{r}+1}\right)\int_{\theta_{1}}^{\theta_{2}}\int_{r_{1}}^{r_{2}}\left(\frac{R_{\text{ref}}}{r}\right)^{n-1}\left(\frac{r}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n}\exp(-in\phi)drd\phi$$
(72)

ここでまず上式の積分中を第1項目と第2項を分けて計算する. $n \neq 2$ の場合

$$(1\text{st term}) = \frac{1}{2-n} R_{\text{ref}}^{n-1} (r_2^{2-n} - r_1^{2-n}) \int_{\theta_1}^{\theta_2} \exp(-in\phi) d\phi$$
(73)

$$= \frac{R_{\text{ref}}}{2-n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}} \right)^{2-n} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}} \right)^{2-n} \right] \frac{i}{n} \left[\exp(-in\theta_2) - \exp(-in\theta_1) \right]$$
(74)

n=2の場合

$$(1st term) = R_{ref} \ln (r_2/r_1) \int_{\theta_1}^{\theta_2} \exp(-in\phi) d\phi$$
(75)

$$= R_{\rm ref} \ln \left(r_2/r_1 \right) \frac{i}{n} \left[\exp(-in\theta_2) - \exp(-in\theta_1) \right]$$
(76)

次に第2項を計算する.

$$(2nd term) = \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \frac{1}{n+2} \frac{R_{ref}^{n-1}}{R_{yoke}^{2n}} \left(r_2^{n+2} - r_2^{n+2}\right) \int_{\theta_1}^{\theta_2} \exp(-in\phi) d\phi$$
(77)

$$= \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \frac{R_{\text{ref}}}{n + 2} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}}\right)^{n+2} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}}\right)^{n+2} \right] \frac{i}{n} \left[\exp(-in\theta_2) - \exp(-in\theta_1) \right]$$
(78)

ここで,第1項と2項をまとめると, $n \neq 2$ の時,

$$C(n)\exp(-in\alpha_n) = -\left(\frac{\mu_0 J R_{\text{ref}}}{2\pi n}\right) \left\{ \frac{1}{2-n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} \right] + S_n \right\} i \left[\exp(-in\theta_2) - \exp(-in\theta_1) \right]$$
(79)

$$B_n = -\left(\frac{\mu_0 J R_{\text{ref}}}{2\pi n}\right) \left\{ \frac{1}{2-n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} \right] + S_n \right\} \left[\sin(n\theta_2) - \sin(n\theta_1) \right]$$
(80)

$$A_n = -\left(\frac{\mu_0 J R_{\text{ref}}}{2\pi n}\right) \left\{ \frac{1}{2-n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} \right] + S_n \right\} \left[\cos(-in\theta_2) - \cos(-in\theta_1) \right]$$
(81)

ここで

$$S_n = \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 1}\right) \frac{1}{n+2} \left(\frac{R_{\text{ref}}}{R_{\text{yoke}}}\right)^{2n} \left[\left(\frac{r_2}{R_{\text{ref}}}\right)^{n+2} - \left(\frac{r_1}{R_{\text{ref}}}\right)^{n+2} \right]$$
(82)

とした.

n=2の時,

$$C(n)\exp(-in\alpha_2) = -\left(\frac{\mu_0 J R_{\rm ref}}{4\pi}\right) \left[\ln(r_2/r_1) + S_2\right] i \left[\exp(-2i\theta_2) - \exp(-2i\theta_1)\right]$$
(83)

$$B_{2} = -\left(\frac{\mu_{0}JR_{\text{ref}}}{4\pi}\right) \left[\ln\left(r_{2}/r_{1}\right) + S_{2}\right] \left[\sin(2\theta_{2}) - \sin(2\theta_{1})\right]$$
(84)

$$A_{2} = -\left(\frac{\mu_{0}JR_{\text{ref}}}{4\pi}\right) \left[\ln\left(r_{2}/r_{1}\right) + S_{2}\right] \left[\cos(2\theta_{2}) - \cos(2\theta_{1})\right]$$
(85)

B.6 4 極電磁石の場合

4 極電磁石の場合, $\theta = \pi/4$ の軸に対し対称な位置にリターン導体が置かれる.また,2つ目のコイルは y 軸に対して対称,これら2つのコイルはメディアンプレーンに対し対称な位置に3つ目と4つ目のコイルが設置される (図 39).

これらの8つの扇形の電流ブロックを足し合わせると, $n \neq 2$ の場合,

$$B_{n} = -\left(\frac{\mu_{0}JR_{\text{ref}}}{\pi n}\right) \left\{ \frac{1}{2-n} \left[\left(\frac{r_{2}}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} - \left(\frac{r_{1}}{R_{\text{ref}}}\right)^{2-n} \right] + S_{n} \right\} \left[\sum_{k=1}^{4} (-1)^{k-1} \cos \frac{n(k-1)}{2} \pi \right] \left[\sin(n\theta_{2}) - \sin(n\theta_{1}) \right]$$
(86)
(87)



図 39:4 極扇形導体断面図

n=2の場合,

$$B_{2} = -\left(\frac{4\mu_{0}JR_{\text{ref}}}{\pi}\right) \left[\ln\left(r_{2}/r_{1}\right) + S_{2}\right] \left[\sin(2\theta_{2}) - \sin(2\theta_{1})\right]$$
(88)

$$A_{2} = 0$$
(89)

となる. 式の導出は読者にまかせる. また $n = 2(2k+1), k \in \mathbb{Z}$ 以外は zero となる. この時の $n \in Allowed$ Multipole と呼ばれている. コイルが完全に対称に作られている場合, Allowed Multipole のみ が発生する. 従ってコイル設計では 4 極以外の Allowed Multipole を小さくするように設計される. 4 極電磁石の Allowed multipole は 12 極 (n = 6), 20 極 (n = 10), 28 極 (n = 14), ...である. ここで, コイル形 状で $\theta_1 = 0$ とする. 12 極成分をゼロにするには $\theta_2 = \pi/6$ となるようにする.

さらに高次の磁場を消去するためには扇形ブロックの数を増やす.これにより自由度が増えより 高次の項を小さくすることが出来る.

参考文献

- 土屋 清澄. "超伝導電磁石". Japanese. In: OHO 加速器セミナーテキスト. 1987.
- [2] 新富孝和. "超伝導の基礎と応用". Japanese. In: *OHO* 加速器セミナーテキスト. 1992.
- [3] 大内徳人,尾崎俊幸, and 土屋 清澄. "超伝 導電磁石". Japanese. In: OHO 加速器セミ ナーテキスト. 1992.
- [4] 荻津 透. "加速器用超伝導磁石". Japanese.In: OHO 加速器セミナーテキスト. 2011.
- [5] 大西 幸喜. "ルミノシティフロンティア".
 Japanese. In: *OHO* 加速器セミナーテキスト. 2004.
- [6] 船越 義裕. "SuperKEKB のマシンパラメー タ〜ナノビーム方式と低エミッタンス". Japanese. In: *OHO* 加速器セミナーテキス ト. 2011.
- [7] Yukiyoshi Ohnishi et al. "Accelerator design at SuperKEKB". In: *Progr. Theor. Exp. Phys.* 2013.3 (Mar. 2013), 03A011. DOI: 10.1093/ ptep/pts083.
- [8] N. Ohuchi et al. "DESIGN OF THE SU-PERCONDUCTING MAGNET SYSTEM FOR THE SuperKEKB INTERACTION REGION". In: Proceedings of NA-PAC. Pasadena, California, Sept. 2013, p. 759. URL: http://accelconf.web.cern.ch/ accelconf/pac2013/papers/weoda1.pdf.
- [9] 大内 徳人. "SuperKEKB ビーム最終集束 用超伝導電磁石の製作". In: 加速器 15.4 (2018), pp. 253-262.
- [10] 札軒 富美夫 et al. "超伝導加速器用極低温 非磁性ステンレス鋼 [YUS130S] の開発".
 Japanese. In: まてりあ 40.2 (2001), pp. 181– 183. DOI: 10.2320/materia.40.181.
- [11] Norihito Ohuchi et al. "Design and Construction of the SuperKEKB QC1 Final Focus Superconducting Magnets". In: *IEEE Trans. Appl.*

Supercond. 25.3 (2015), p. 4001204. DOI: 10. 1109/TASC.2014.2364858.

- [12] N. Ohuchi et al. "MAGNETIC FIELD MEASUREMENT SYSTEM FOR THE SuperKEKB FINAL FOCUS SUPERCON-DUCTING MAGNETS". In: Proceedings of IPAC. Dresden, Germany, June 2014, p. 2693. URL: http://accelconf.web.cern.ch/ AccelConf/IPAC2014/papers/wepri087. pdf.
- [13] Y. Arimoto et al. "SUPERCONDUCTING MAGNET SYSTEM FOR THE INTER-ACTION REGION OF SUPERKEKB
 MAGNETIC MEASUREMENT OF QUADRUPOLE MAGNETS WITH HAR-MONIC COILS -". In: Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan. Nagaoka, Japan, Aug. 2018, THP065.
- [14] Y. Arimoto et al. "Magnetic Measurement for Superconducting-Quadrupole-Magnets of Final-Focus System for SuperKEKB". In: Proceedings of the 7th Int. Particle Accelerator Conf. (IPAC'16). Busan, Korea, 2016, THPOR004. ISBN: 978-3-95450-147-2. DOI: doi : 10 . 18429 / JACoW - IPAC2016 -THPOR004. URL: http://jacow.org/ ipac2016/papers/thpor004.pdf.
- [15] 大木俊征 and 中村衆. "SuperKEKB 電磁石 電源 -高安定度電源の開発-". In: 低温工 学 53.3 (2018), pp. 146–153. DOI: 10.2221/ jcsj.53.146.
- [16] A. K. Jain. "CERN-98-05". In: ed. by S. Turner.
 CERN, 1988. Chap. "Basic theory of magnets", pp. 1–26. DOI: 10.5170/CERN-1998-005.
- [17] Richard A. Beth. "An Integral Formula for Two
 Dimensional Fields". In: Journal of Applied Physics 38.12 (1967), pp. 4689–4692. DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1. 1709204. URL: http://scitation.aip.

org/content/aip/journal/jap/38/12/ 10.1063/1.1709204.